

二個要點即可輕易分辨：(1) (類似電場中的電力線方向由正極指向負極) 圖中箭頭方向為指出 p 型矽基底，但指向 n 型矽基底，(2) 為了表示常開型在 $V_G=0$ 時就有通道存在，半導體基底表面特別加上一實心粗線代表通道；反之，則為常關型。舉例說明，圖 4-2(a) 中的箭頭指向基底，故為 n 型基底，是為一 p 通道 MOSFET 元件；又圖中基底表面並無實心粗線，是屬於常關型。

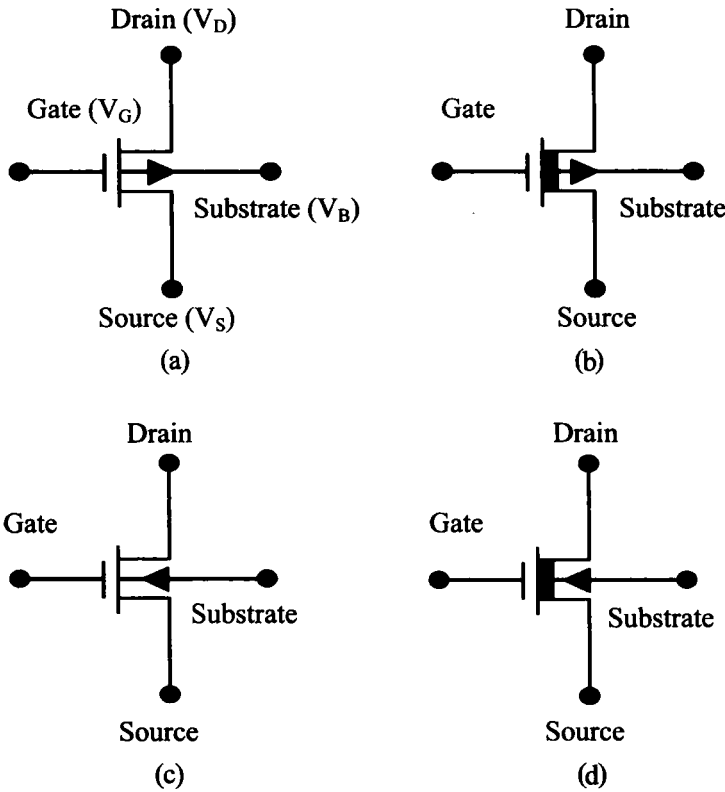


圖 4-2 四種型式 MOSFET 之電路符號：(a)增強型（或常關型）p 通道 (b)空乏型（或常開型）p 通道 (c)增強型（或常關型）n 通道 (d)空乏型（或常開型）n 通道。

上述四種類型 MOSFET 之比較整理於表 4-1 中。不論對 n 通道或是 p 通道而言，由表 4-1 可知增強模式與空乏模式之基本結構（閘極、源極、汲極、和基板摻雜型態）大致上是相同的，其最大差異處在於臨界電壓的極性是正負號相反的，這也是直接決定在零閘極偏壓下之通道的存在與否。以 n-MOSFET 為